

## 「パワーエレクトロニクス」試験問題

注意：1) 裏にも問題があります。

2) 計算過程も解答用紙に記入のこと。

平成 15 年 9 月 22 日実施

担当：伊瀬 教授

[1] パワーエレクトロニクス機器の長所と問題点を述べよ。(10 点)

[2] 次のパワー半導体デバイスの英語略語をフルネームで表現するとともにそれぞれのデバイスの特徴を述べよ。(21 点)

(a)GTO, (b)IGBT, (c)MOSFET

[3] 負荷の電圧  $v$  と電流  $i$  が下記である。ただし、 $\omega$  は電源角周波数である。(20 点)

$$v = V_d + \sqrt{2}I_1 \sin \omega t + \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t$$

$$i = I_d + \sqrt{2}I_1 \sin(\omega t - \theta_1) + \sqrt{2}I_3 \sin(3\omega t - \theta_3) + \sqrt{2}I_5 \sin(5\omega t - \theta_5)$$

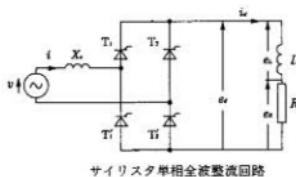
このとき、以下の諸量を求めよ。

(a)負荷に供給される有効電力  $P$

(b) $v$  および  $i$  の実効値

(c)負荷の総合力率  $pf$

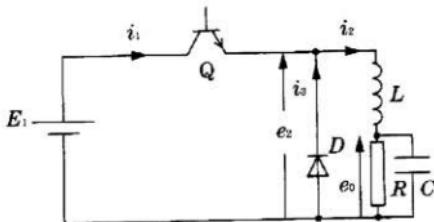
[4] 図に示す単相全波整流回路で直流電流  $I_d$  の平均値  $I_a$  が 20A であるとき、サイリスタに流れる電流の平均値と実効値を求めよ。ただし、平滑リアクトル  $L$  のインダクタンスは十分に大きく直流電流は平滑化されており、また、電源リアクタンス  $X_s=0$  とする。(14 点)



サイリスタ 単相全波整流回路

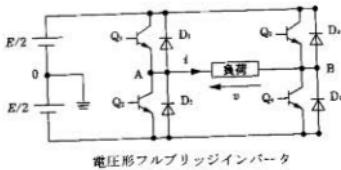
[5] 降圧チョッパにおいて、図のように負荷抵抗  $R$  と並列に十分に大きなコンデンサ  $C$  を接続して負荷電圧を平滑化することが行われる。この構成において、下記の各間に答えよ。(15点)

- (a) 負荷電圧  $e_0$  の平均値) と入力電圧  $E_1$  の関係を示せ。ただし、トランジスタ  $Q$  の通流率は  $d$  とする。
- (b) トランジスタ  $Q$  の通流率が  $d$  における電流  $i_2$  のリップル成分  $I_{\text{max}} - I_{\text{min}}$  を求めよ。
- (c) 電源電圧  $E_1 = 100V$ 、負荷抵抗  $R = 1\Omega$  で、負荷抵抗  $R$  の電流を 40A に制御するとき、電流  $i_2$  のリップル成分を 4A に抑えるためには平滑リアクトル  $L$  のインダクタンスをいくらに設定すれば良いか。ただし、スイッチング周波数を 10kHz とする。



[6] 図に示す電圧形フルブリッジインバータ回路により図に示すような方形波電圧を発生するものとする。電源電圧  $E=200V$ 、負荷は純抵抗で  $20\Omega$  とする。このとき、次の値を求める。(20点)

- (a) 負荷電流  $i$  の実効値  
 (b) 負荷電流  $i$  の基本波成分実効値  
 (c) 負荷電力の平均値  
 (d) 直流電源電流の平均値



電圧形フルブリッジインバータの動作波形

以上